







	<h2>SI5515DC-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5515DC-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 20V 4.4A 1206-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5515DC-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 21269 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 4.4A 1206-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	21269 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 4.4A, 4.5V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 4.5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A, 3A

SI5515DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5515DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5515DC-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5515DC-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5515DC</b> 98K SI5515DC 98K</p>	 <p><b>SI5515CDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5515DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5515CDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p>
 <p><b>SI5515CDC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5517DU-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 6A CHIPFET</p>	 <p><b>SI5515DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5515DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>

### SI5515DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<a href="#">Schlüsselwort</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>
<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>
<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>
<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>	<a href="#">SI5515DC-T1-E3</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited